

**КТ646А,Б,В**

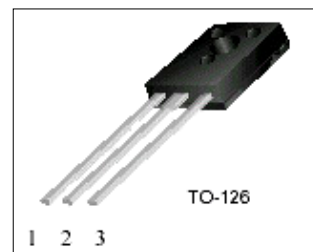
**PNP КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЕ  
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРАНЗИСТОРЫ**

**аАО. 336.334 ТУ**

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРИЁМОУСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМАХ, ОПЕРАТИВНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ И ДРУГОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЕ.

\* Зарубежный аналог: **КТ646А-2SC495, КТ646Б-2SC496.**

\* Изготавливается в корпусе **КТ-27 (ТО-126).**



**1 – эмиттер 2 -коллектор 3 - база**

**ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение		
			А	Б	В
Напряжение коллектор-эмиттер	Укэ max	В	60	40	40
Напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	4	4	4
Напряжение коллектор-база	Укб max	В	60	40	40
Постоянный ток коллектора	Ik max	мА	1000	100 0	100 0
Температура перехода	Тпер	°С	150	150	150

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Токр.ср.=+25°С )**

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора КТ646А КТ646Б КТ646В	Ikбо	мкА	Укб=60 В Укб=40 В Укб=35 В	-	10 10 0,05
Статический коэффициент передачи тока КТ646А КТ646Б КТ646В	h <sub>21э</sub>		Укб=5 В, Iэ=200мА Укб=10 В, Iэ=500мА	40 150 150	200 - 340
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ646А КТ646Б КТ646В	Укэ (нас)	В	Ik=500мА, Ib=50 мА Ik=200мА, Ib=20 мА Ik=500мА, Ib=50 мА	-	0,85 0,25 0,25
Напряжение насыщения база - эмиттер	Уэб(нас)	В	Ik= 500мА, Ib=50мА	-	1,2
Емкость коллекторного перехода*	Ск*	пФ	Укб= 10 В, Iэ= 0, f= 10 <sup>7</sup> Гц	-	10
Емкость эмиттерного перехода*	Сэ*	пФ	Уэб= 0 В, f= 10 <sup>7</sup> Гц	-	80
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мкА	Уэбо= 4В	-	10

**220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"**

**Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32**

**E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by) <http://www.transistor.by>**